

平成30年度 応用物理学会 多元系化合物・太陽電池研究会 年末講演会

2018年11月30日（金）～ 12月1日（土）

開催場所：東京理科大学 神楽坂キャンパス

プログラム

11月30日（金）

- 13:30 - 研究会委員長挨拶：和田隆博（龍谷大学）
- 13:40 - 招待講演 内富直隆（長岡技術科学大学）
O01-「多元系強磁性半導体薄膜の現状と展開」
- 14:20 - 招待講演 工藤昭彦（東京理科大学）
O02-「金属酸化物および硫化物光触媒を用いた
水分解および二酸化炭素還元 -人工光合成を目指して-」
- 15:00 - 休憩
- 15:20 - 一般講演 O03-O05
- 16:30 - ポスターセッション P01-P25
- 18:00 - 意見交換会

12月1日（土）

- 9:30 - 招待講演 植田譲（東京理科大学）
O06-「太陽光発電の主力電源化に向けた
システム技術開発と系統連系」
- 10:10 - 一般講演 O07-O11
- 11:45 - 閉会の辞



※意見交換会会場は
10号館食堂です。
発表会場から少し
距離があります。

学生が誘導します。

2018年度 多元系化合物・太陽電池研究会 年末講演会 プログラム

口頭発表：11/30(金)

番号	発表時間	所属	氏名	発表タイトル
O-1	13:40 - 14:20	長岡技術科学大学	内高直隆	多元系強磁性半導体薄膜の現状と展開
O-2	14:20 - 15:00	東京理科大学	工藤昭彦	金属酸化物および硫化物光触媒を用いた水分分解および二酸化炭素還元ー人工光合成を目標してー
O-3	15:20 - 15:40	木更津工業高等専門学校	岡本 保	過酷炉心放射線環境における線量測定装置の開発
O-4	15:40 - 16:00	千葉工業大学	安井 祐人	放射線検出器用TiBr結晶における低エネルギー領域の発光
O-5	16:00 - 16:20	千葉大学	石川真人	第一原理計算を用いたTiInS ₂ のドーピングによる電子状態解析

口頭発表：12/1(土)

O-6	9:30 - 10:10	東京理科大学	植田 謙	太陽光発電の主力電源化に向けたシステム技術開発と系統連系
O-7	10:10 - 10:30	防衛大学校	中山 勇輝	稀酸鉄(III)を添加した硫酸によるCZTS薄膜の表面処理
O-8	10:30 - 10:50	東京理科大学	Tzu-Ying Lin	Cesium-induced Surface Modification on Cu(In,Ga)Se ₂ Thin Film using Cesium Fluoride Post Deposition Treatment without Selenium-vapor Supply
O-9	10:50 - 11:05	筑波大学	陳敬東	Cu(In,Ga)(S,Se) ₂ 太陽電池のセシウム処理 に対する再結合解析
O-10	11:05 - 11:25	千葉大学	赤井 慧	ハロゲン化鉛ペロブスカイトにおけるドーパントの特性:第一原理計算による検討
O-11	11:25 - 11:45	東京理科大学	生野孝	光駆動型カーボンナノチューブ浮揚体の創製

ポスター発表：11/30(金)

番号	発表時間	所属	氏名	発表タイトル
P-1	16:30 - 17:45	千葉工業大学	島田新大	PLD法CuInS ₂ 薄膜のSアニール温度による異相の変化
P-2	16:30 - 17:45	岡山理科大学	西村拓哉	CuInSe ₂ の合成と物性評価
P-3	16:30 - 17:45	千葉工業大学	後藤 優太	PLD法によるCZTS薄膜とターゲットとの組成比の関係
P-4	16:30 - 17:45	長岡工業高等専門学校	坪井 大	太陽電池への応用に向けたCu ₂ ZnSnS ₄ /バルク結晶の物性評価
P-5	16:30 - 17:45	長岡技術科学大学	阿部矩方	溶液塗布法によるCu-Sn-Si-S薄膜の作製
P-6	16:30 - 17:45	長岡技術科学大学	Le Huu Nghia	微粒子塗布法によるCu-Sn-Si-S薄膜の作製
P-7	16:30 - 17:45	長岡技術科学大学	山本恭平	ゾルゲル硫化法によるCu ₂ Sn _{1-x} GexS ₃ 薄膜の作製法の検討
P-8	16:30 - 17:45	長岡技術科学大学	木幡真緒	ミスTCVD法によるCu ₂ SnS ₃ 薄膜の作製の試み
P-9	16:30 - 17:45	東京理科大学	Mohamed Samir	Low Temperature Hydrothermal Preparation and Characterization of Cu ₂ SnS ₃ Powder
P-10	16:30 - 17:45	東京理科大学	船津 岳伸	熱処理雰囲気SnS薄膜に与える影響
P-11	16:30 - 17:45	山梨大学	井上 和俊	Brドーピング型SnS単結晶育成と物性評価
P-12	16:30 - 17:45	山梨大学	Rizky	近接昇華法により作製したSnS薄膜に対するBr添加の影響
P-13	16:30 - 17:45	山梨大学	佐藤 孝一	近接昇華法を用いたSnS薄膜の作製と評価
P-14	16:30 - 17:45	東京理科大学	藤本康平	TMDCナノ構造薄膜を用いた色素増感型太陽電池の高電圧化
P-15	16:30 - 17:45	東京理科大学	大久保匠	フレキシブル基板へのTiO ₂ 多孔質膜の転写技術
P-16	16:30 - 17:45	東京理科大学	岡田浩明	インテリジェントウインドウに向けた酸化物半導体を用いた透明電子デバイスの作製
P-17	16:30 - 17:45	東京理科大学	加藤匠秀	NiO系可視光透過型太陽電池の曲げ及び電子線照射による耐性
P-18	16:30 - 17:45	長岡技術科学大学	手塚尚人	溶液塗布法によるCuBr _{1-x} I _x /ZnOナノロッド透明微細構造pn接合の作製
P-19	16:30 - 17:45	長岡技術科学大学	今村俊貴	CuBr _{1-x} I _x 薄膜発光スペクトルの組成比依存
P-20	16:30 - 17:45	大阪府立大学	北野稜汰	3元タリウム化合物における光誘起変形のミリ秒過渡応答特性評価
P-21	16:30 - 17:45	大阪府立大学	板倉涼介	層状3元タリウム化合物における光誘起変形の異方性
P-22	16:30 - 17:45	大阪府立大学	井上直紀	半導体ナノ粒子多層膜における粒子間相互作用の誘電率スペクトルへの影響
P-23	16:30 - 17:45	長岡技術科学大学	蔦 将哉	KSr _{1-x} BaxPO ₄ に添加したEuの化学的および光学的な還元特性
P-24	16:30 - 17:45	筑波大学	Imane Abdellaoui	Structural and Electrical Properties of Zr doped ms-BiVO ₄
P-25	16:30 - 17:45	長岡技術科学大学	打木久雄	2核Eu錯体結晶のEu ³⁺ における結晶場の温度依存性